静电场

第五讲 高斯定理的应用

利用高斯定理求电场:

当电荷(因而电场)分布具有一定对称性时,利用高斯定理求电场,可简化运算过程。

对电场对称性的要求:

- ●高斯面上场强大小处处相等;
- ❷场强方向与高斯面上单位法线矢量的夹角 处处相等。

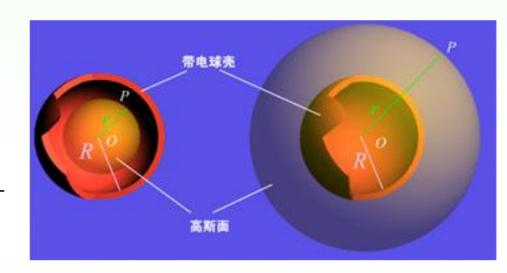
此时:
$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S} E \, dS \cos \theta = E \cos \theta \iint_{S} dS = \frac{1}{\varepsilon_{\theta}} \sum_{(S \nmid I)} q_{i}$$

1. 均匀带电球面的电场分布 (R,q):

电场具有球对称分布。

$$r > R$$
 时: $\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

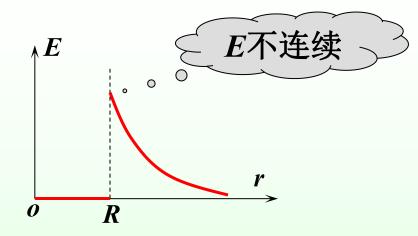
由高斯 定理得 $= E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_{\theta}}$



$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$r < R$$
 时: $\Phi_F = E \cdot 4\pi r^2 = 0$

$$\therefore E = 0$$



2. 均匀带电球体的电场分布 (R, q):

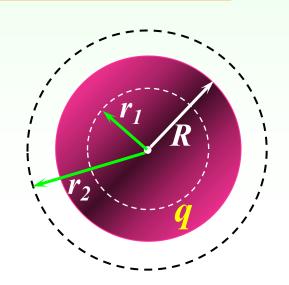
由高斯定理得
$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

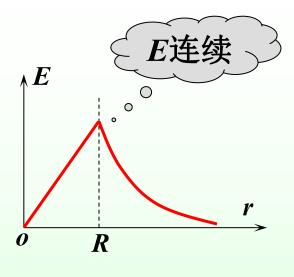
球体外的电场:与球面外电场相同。

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (r \ge R)$$

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{qr^3}{R^3}$$

$$\therefore E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \qquad (r \le R)$$





3. 无限长均匀带电圆柱体的电场 (λ, R)

电场具有轴对称分布,由高斯定理得 $r \ge R$ 时:

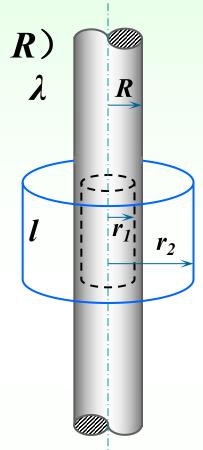
$$\Phi_{E} = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \iint_{\mathbb{Q}} dS = E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_{\theta}}$$

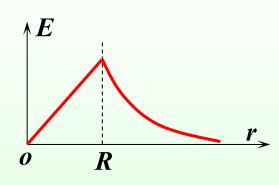
$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

r≤R时:

$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda l}{\pi R^2 l} \cdot \pi r^2 l$$

$$\therefore E = \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2}$$





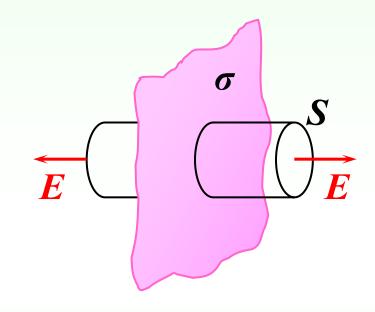
4. 无限大均匀带电平面的电场(σ):

对称性分析: 距离平面有限远处电场的大小相等, 方向垂直于平面。

取图示的高斯面,只有圆柱的左、右底面有电通量。

由高斯定理得

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2ES = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma S$$



$$\therefore E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

思考题:

两块无限大带等量异号电荷的平行平面的电场分布。